#### *Приложение 2*

##### Требования к оформлению тезисов

Тезисы докладов предоставляются в электронном виде. Объём тезисов – 2 страницы.

1-я строка – тема доклада, шрифт Arial 15 пт., прописной полужирный

2-я строка – пустая

3-я строка – Фамилия И.О. авторов, шрифт Arial 13 пт., строчный полужирный,

4-я строка – название организации, шрифт Arial 12 пт., строчный курсив.

Основной текст отделяется от заголовка пустой строкой. Текст должен быть подготовлен в Word (тип файла «Документ Word 97-2003»), шрифт Arial 14 пт., через 1 интервал, все поля 25 мм, отступ абзаца 0,7 см. Подрисуночные подписи - шрифт Arial 12 пт. Рисунки черно-белые, цветные рисунки не допускаются.

Список библиографических ссылок отделяется от текста пустой строкой, шрифт Arial 12 пт., заголовок «Список источников» не печатается.

Образец оформления тезисов доклада приведен в *Приложении 3*.

##### *Приложение 3*

##### *Пример оформления тезисов*

**Алгоритмы идентификации параметров**

**тепловых цепей полупроводниковых приборов**

**Фролов И. В.1, Сергеев В. А.1, Закгейм А. Л.2, Черняков А. Е.2**

*1УФИРЭ им. В. А. Котельникова РАН*

*2Научно-технологический центр микроэлектроники*

*и субмикронных гетероструктур Российской академии наук*

Известные способы идентификации параметров тепловой эквивалентной схемы полупроводниковых приборов (ППП) в зависимости от вида динамической тепловой характеристики, используемой для расчета, разделяются на две группы: способы, основанные на анализе переходных (импульсных) тепловых характеристик (ПТХ) ППП, то есть изменения температуры перехода во времени при нагреве прибора ступенькой (импульсом) греющей мощности [1], и способы, основанные на анализе............

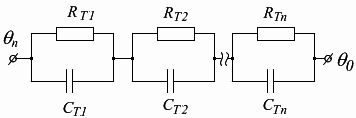


Рис. 1. Одномерная эквивалентная *n*-звенная тепловая схема ППП по Фостеру

Разработанный алгоритм апробирован на примере идентификации и расчета параметров эквивалентных тепловых схем коммерческих гетеропереходных светодиодов.

1. Пат. RU 2392631 РФ, МПК G01R31/26. Устройство для измерения теплового сопротивления переход-корпус полупроводникового прибора / Мальцев И. А., Мальцев А. А.; заявитель и патентообладатель Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева. – № 2009122088/28; заявл. 09.06.2009; опубл. 20.06.2010. Бюл. №17.

2. Сергеев В. А., Смирнов В. И., Гавриков А. А., Фролов И. В. Измерение теплового импеданса мощных светодиодов с применением широтно-импульсной модуляции мощности // Известия вузов. Электроника. – 2012. – №3. – С. 64–68.